




	<h2 style="color: red;">SI3983DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3983DV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3983DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3983DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	16000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	830mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 2.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)














SI3983DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3983DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3983DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3983DV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3993CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3983DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3983DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3991DV-T1-GE3</b> VISHAY SI3991DV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p><b>SI3993CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3993</b> VISHAY SI3993 VISHAY</p>	 <p><b>SI3981DV0-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI3981DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3900DV-T1-E3	 SI3900DV-T1-E3	 SI3900DV-T1-GE3	 SI3900DV-T1-GE3	 SI3905DV-T1
 SI3905DV-T1-E3	 SI3905DV-T1-E3	 SI3905DV-T1-GE3	 SI3905DV-T1-GE3	 SI3909DV-T1
 SI3909DV-T1-E3	 SI3909DV-T1-E3	 SI3909DV-T1-GE3	 SI3909DV-T1-GE3	 SI3911DV
 SI3911DV-T1	 SI3911DV-T1-E3	 SI3911DV-T1-E3	 SI3911DV-T1-G33	 SI3911DV-T1-GE3
 SI3911DV-T3-E3	 SI3915DV	 SI3915DV-T1-E3	 SI3915DV-T1-GE3	 SI3932DV-T1-GE3
 SI3932DV-T1-GE3	 SI3948DV-T1	 SI3948DV-T1-E3	 SI3948DV-T1-E3	 SI3948DV-T1-GE3
 SI3948DV-T1-GE3	 SI3951-KU	 SI3951DV-T1-E3	 SI3951DV-T1-E3	 SI3951DV-T1-GE3
 SI3951DV-T1-GE3	 SI3981DV-T1-E3	 SI3981DV-T1-E3	 SI3981DV-T1-GE3	 SI3981DV-T1-GE3
 SI3983DV-T1-E3	 SI3983DV-T1-E3	 SI3983DV-T1-GE3	 SI3991DV-T1-GE3	 SI3993CDV-T1-GE3
 SI3993CDV-T1-GE3	 SI3993DV-T1-E3	 SI3993DV-T1-E3	 SI3993DV-T1-GE3	 SI3993DV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited